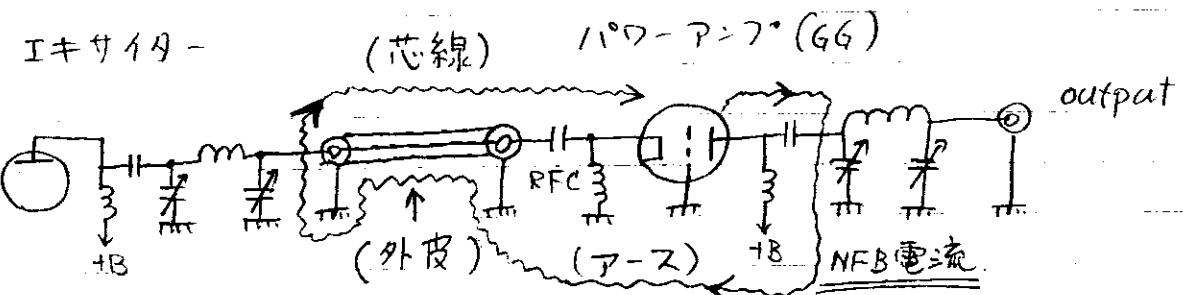


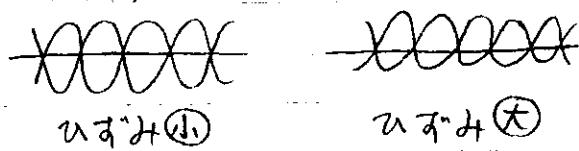
3. 入力同調回路 → 諸定数は KSO のり=アの本(成文堂新光社)や CQ のり=アの本などご覧ください。

GGアンプでは IMD 特性を良好に保つために入力同調回路は不可欠です。インピーダンス整合のためにも重要です。もちろん高調波やバンド外スプリアスの軽減にも役立ちます。



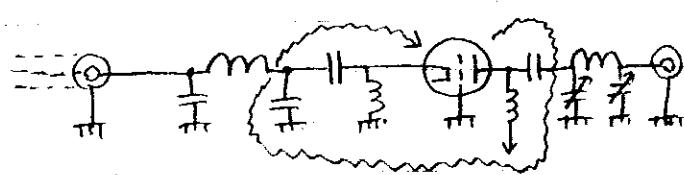
GGアンプは名物の NFB がかかります。プレートに発生した RF がプレート回路からカソードにもどりたいわけですが、入力同調回路をもたない GGアンプではこの NFB 電流はグランドから入力の同軸の外被(アース)を通ってエキサイタ-のタントロード(VC)を経て、同軸の芯線を通って GG のカソードへもどります。

エキサイタ-出力 NFBによる歪の発生



そのため本来のエキサイタ-信号は歪をうけ、エキサイタ-負荷も GGリニア側の負荷によく影響をうけることがあります。

- これを防ぐためにも入力同調回路が必要になります。



たとえば同じインピーダンスで $Q=5$ の回路定数を求めるには $Q=2$ のときの表から

C_1, C_2 の値 $\rightarrow 2.5$ 倍, L の値 $\rightarrow \frac{1}{2.5}$ 倍

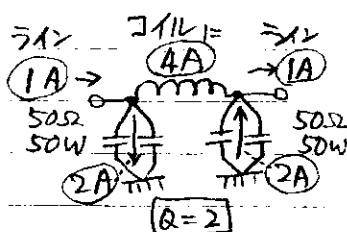
といふことはよいのです。

(また 100Ω で $Q=2$ の回路は 50Ω を使うと $Q=1$ となります。)

この回路の Q は 1~2程度より多いことが多いうのが確か。真空管によると $Q=2, Q=5$ 以上と高めの値の方がよい、と書かれていることもあります。(よりハイCの回路)

$Q=2$ のとき、無調整式の実用範囲は およそ 5~10% (14MHz 2~0.7~1.4MHz 中間) くらいと思われます。 $Q=5$ の半分以下。 $(\frac{1}{2.5})$

- Q が高いため回路を流れ RF 電流が大きくなります。 50Ω でドライブ電力 $50W$, $Q=2$ とすると (このラインを流れる電流 I は $1A$, $(\because I = \sqrt{\frac{P}{Z}})$) C に流れる電流は $Q \times I = 2A$, コイルには $2+2 = 4A$! ドライブ電力が $200W$ なら電流は $4A$, (コイル $I = 8A$), $Q=5$ のときは $200W$ のとき, なんと $10A$ ($20A$) ! コイル・コンデンサーの発熱は馬鹿にならないモスクワサとなります。(=損失じゃ。)



- そのため, FL 2100 ニーズでは簡単のため, $Q=1$ と低目です。
- ある程度の RF 電圧・電流に耐えるようにするためにには小容量の C を数個並列接続しなければならないことがあります。(その方が安くできるし小型化できる。)

- 入力・出力とも 50Ω , $Q=2$, ドライブ電力 $100W$ のとき回路電流は $2.8A$, コンデンサーの電圧は $E = \sqrt{PZ} = 50\sqrt{2} = 70V$ (これは Q 信しない。あくまでも C 両端にかかる電圧) となるので、コンデンサーの DC 耐圧は $\times 2\sqrt{2}$ をえて $200V$ (または $300V$ RF-Volts) 以上必要です。一方、 C に流れる電流 = $RF\text{-電圧}/X_C = \sqrt{PZ}/X_C = \text{ライン電流} \times Q$ です。チタコン(セラミックコン)の電力用のものが最適ですが、手頃な物がないときは、 $500V$ マイカ(または $1KV$ マイカ)を数本から 10 本くらい 1 本に必要な容量と耐圧・耐電流をとります。(一番手頃。)

- $Z = 50\Omega$, ドライブ $100W$ のとき、ライン電流 = $\sqrt{\frac{100}{50}} = 1.4A$, 電圧 = $\sqrt{100 \times 50} = 71V$ ゆえ、タンクの $Q=2$ とすると、 C に流れる電流 = $2 \times 1.4 = 2.8A$, 電圧 = $71V$

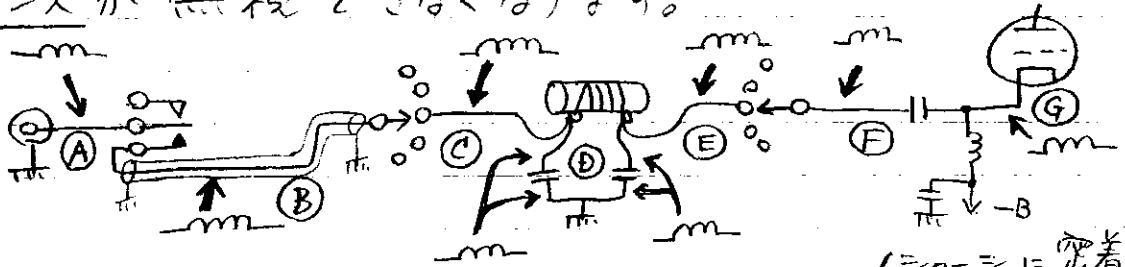
$$\Leftrightarrow \begin{array}{ll} \text{(5本に分割すれば、1本あたり)} & 0.56A, \text{ 約 } 40W \\ \text{10本に " " } & 0.28A, \text{ 約 } 20W \\ \text{= 耐えればよいことになります。} & \end{array}$$

- (注) $Q=1$ のときは、 Q が高いため回路電流が大きいことを忘れないように! つまり、 $100W$ のドライブを 10 本に分けた 1 本あたり $1/10$ の電力をいい、のとはちがうのだ。
- コイル電流は、入力 C と出力 C との中の電流の和!

- ただし、この手の小物パーツでは、1ヶあたり $20-40W$ と見てみれば、 50Ω 入力回路(や出力・アンテナ回路)では足りるようですが。(ただし、耐圧 (RF-Volt) にも注意せよ。)

GGアンプの入力同調回路は、

ローラインピーダンスの回路ですから、配線に使うリード線のインダクタンスが無視できなくなります。



解説

(ジャーシーは空着(2))

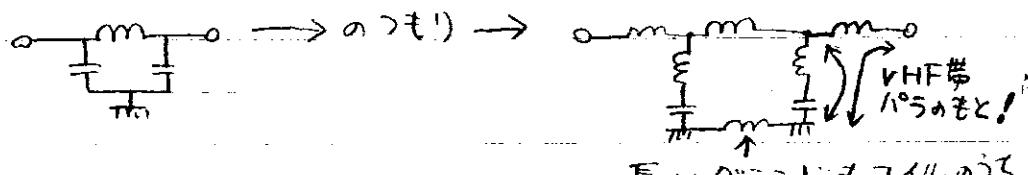
Ⓐ, Ⓑ ... 同軸ケーブルを使う。できるだけ直線的に配線可。

Ⓒ ----- " または、できる限り短かく太く。

Ⓓ ----- とくに短かく太くする。

- これは
入力タップ回路を形成している部分なので特に重要。

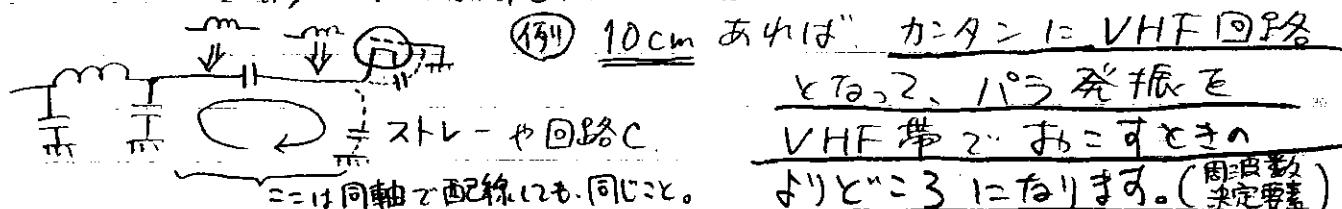
配線がインダクタ～だと簡単に変な回路になる。



- 配線リード 1cmもボビンにまいてあるコイル 1cmも
RF 1cmとは、同様の意味になります。
(たとえどんなに、作った人の思ひ入れが強くとも。)

Ⓔ, Ⓛ, Ⓞ ... NFB の L-7° があるので、これが長たらしく
せっかくの入力同調回路も、タタの同調回路。
IMD はあまり減らないかも…。 太く短かく美しく。

- さらには
この長たらしく、インダクタ～配線は、伊も簡単に
予想もしないまったく別の「同調回路」(共振回路)
を形成します。



- したときは、ここにも 1波止め
有效です。Qを低下させ?

または M カ
(Lは可)(数+2)

調整 — 動作させる前に必ず おおよその同調をとつみく。

バンドスイッチ周辺は できれば 外で組立て 調整してから 本体に納めるといいです。 ↓ ユニットと

- 配線は前ページ①を中心にして注意します。
- $Q=2$ くらいだと C が比較的小さな 28MHz などでは、球をさしてあるかどうか、タング回路から バンドスイッチ - 球までの配線が実際と同じかどうか etc. など 同調点がズレります。

実際に近い配線 (できれば 銅帯・リボンを使う) をおこなう。球の入力容量相当の C を付加しておきましょう。 ↳ 4-1000A 1本 230pF くらい。

- 上の上で ディップ X-タ - 2 バンド内におきめはまず 実用になります。

あるいは

- カーボン側に 100Ω くらいの P型抵抗 ($3W \sim 5W$ 可) を付け、入力側に TX (SWR計) を接続して 小電力で SWR 曲線を読んでみる。中心がバンド内にあさまっていることを確認します。

(注) 50Ω だと、あまりによくマッチングしまって SWRカーブ (最低点) がわからぬかも知れない。

- バンド切換が上のバンドにあついたくちやタグ 2 や R を付けてますのは、ディップ X-タ - は使いにくい。(ディップが浅く広いため。)

厳密には、球の温度、ソケットの容量、カーボンRFC (フライメントチョーク) のリアクタンス (L分・C分) によつて若干の影響をうけます。よつて、微調整が必要になります。

* 特にローバンドは チョークの L (タングの L との比が小さくなるため) に影響をうける。「コイル」といわれる。

* ハイバンドは C 分の増加で共振点が下がる。

(注意)

フェライトコアは入れると $f \downarrow$ 、(んちゅ) コアは入れると $f \uparrow$ だよ。

・ しんちかうコアーは大電力向き(100W~100W以上)で“可”
し可変範囲が大変せまい。1MHzあたりたぶん動かない
でしょう。(したがって、本体に入れてもう前に必ず回路を組んで、調整しておかないと、あとで大変なことになる。)

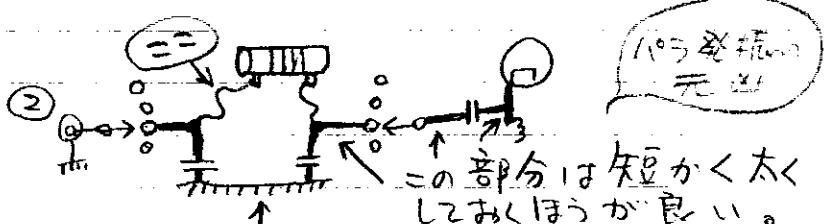
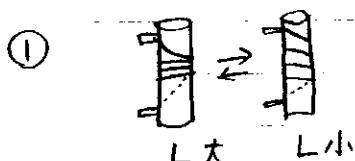
・ ハイバンドでは、しが大変少なくてなるので「巻き数を1ターン増やす(または減らす)」としても、変化が大きすぎてしまう
同音周波数にならない(よ)。

そういうときは、巻き数は少く変えず、コイルの

① スペースを変える(のはして)ちぢめたりする)。

② リードの長さを増減する。(スタートです。)

といふ(よ)。



③ 空心コイルなら

径を変えるのも有効。

小 < 大

同じ3ターンでも

この距離もかなり影響する。

矢立かい方が良い。

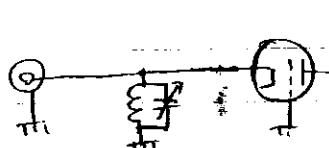
(長くなると $f \downarrow$ かつインダクションも)

↓ インダクション回路は寄生共振の元凶。

・ またハイバンドでは、LのかわりにCを変化させみるのも
簡単かつ効果大です。50~100pFのトリマー(500V)で
1ターンにTuneができます。

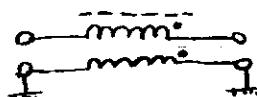
・ 一般に、各バンドのC容量の10%くらいの固定C(マイカ)を
附加してfを下げるのも有効的な手です。
(Lの調整と併用(2))

* 元型以外の回路

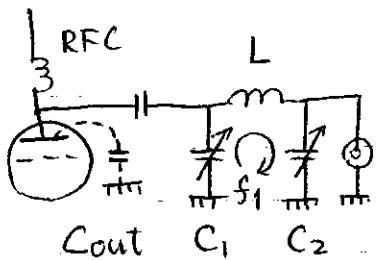


* リーター・バラン

アース電流のしゃ断に有効



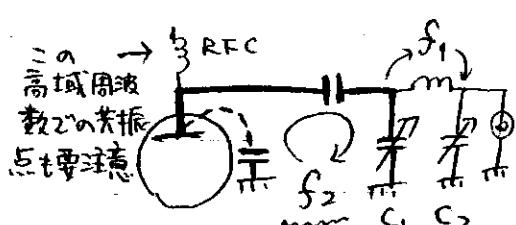
寄生共振回路ないしは偶発的共振回路



HF帯送信機2:

同調周波数 f_1 (MHz) なる π型タンクがあるとき、(= 基本波周波数)

(玉の C_{out} - フレードリード - フロッキニク)
- C_1

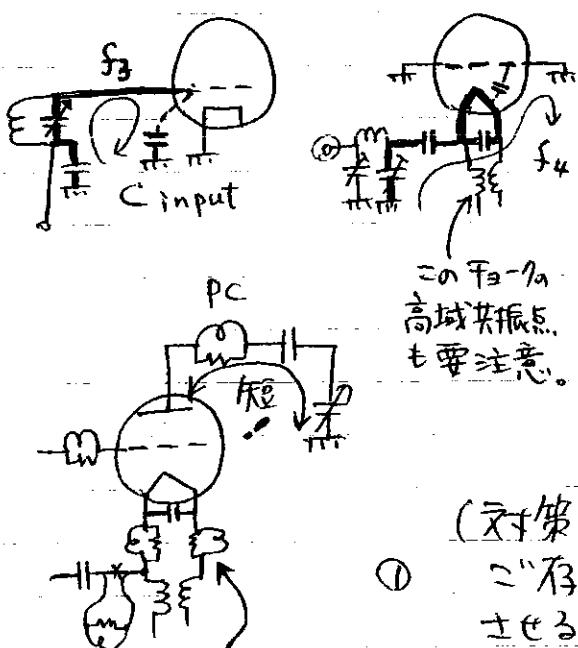


の f_1 - f_2 の VHF 帯域 (数十 ~ 百数十 MHz) の 寄生共振回路が同時に存在します。= f_2 (MHz) → 球周波と V_C の A-S 間も駆動!!
→ この共振回路は、「寄生発振」のときの
フレード側 同調回路の一例です。

この同調回路ひとつでも充分、発振 (自己発振 ~ HF 信号が入った時のみ ~ そのピークなど) の発振) は起り得ます。
→ 音が鳴る、サトードが広がる。= UYUN!

* この共振周波数は

- ① 大型の玉 ~ 大型の部品 (V_C など) ほど 低い周波数域 になり、より発振 (やすくなる) (玉のゲインが高いため)
- ② VHF 帯域 2 の 寄生共振は、HF 帯 2 (HF 機 2) のみ 起り得る。→ VHF 送信機 2 は、寄生共振周波数は、もっと高い周波数域へと移る。あたりまえ。



(対策)

- ① この存知、PC (回路中の VHF イネルギーを吸収させる Q タンバー) を入れる。
- ② 配線を短かく 広い銅帯 2 行 にする。(幅 3cm とか 10cm とか)
- ③ 大型 V_C にかわり、コンパクトな真空コンデンサー

クリード側 カソード側 2 も同様に
(玉の C_{g-k} - クリードリード - 入力側リード)
- 入力同調 C - (パス C) - A-S といふ、寄生共振回路が同時に存在し、不要な発振へスリップ入の
よりど = 3 となる。

$\{ f_2 \div f_3, f_2 \div f_4 \text{ 2発振}$
 $\{ f_3 \text{ または } f_4 \div m \times f_1 \text{ 2強力な高調波が発生。}$

③ 入出力回路のシールドを良くすることは、基本波自己発振をあさる以上 Date

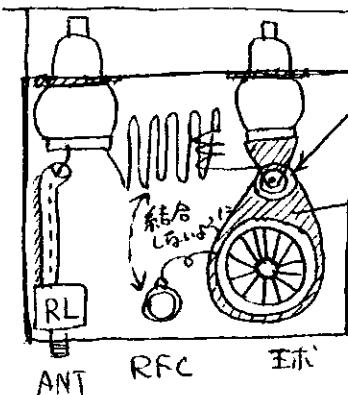
1= VHF帯域2"のパラ発振を防止することにも役立つ。

→複雑な「工夫」や切換回路は「寄生共振」の元凶！

を使用する。固定C附加やタップリードの長さを2"きるだけ減らす。

④ 構造上、リードインダクタンスの小さな球(4CX~など)を使用する。

VC₂ VC₁ ⑤ 部品の配置をよく考へ作る。→上の④



C熱伝導
↑ 真空管
幅広の銅板は熱もよく伝える!!
VHF機を作る要領を守れば"VHF帯パラ
発振は起らない。UHF帯域2"のパラ
は、ゲイン①ゆえ心配ない。

ただし、

(まわりに)

→球(とくにガラス球)は高熱を発するので、
真空バリコンやセラミックコンをあがさない
よう、充分「熱シールド」「冷却」を考慮する。
→ See P. 94-95
… 2"ないと割れNGになります。

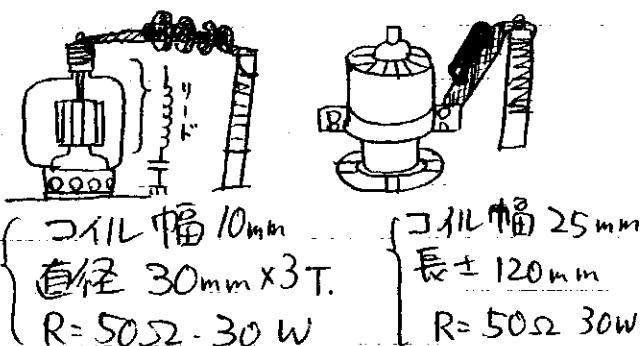
* パラ止め LR は

① 基本的には、パラ発振(2"ないときは R のワット-シ)は L に発生する基本波に耐えねばならない。

(例) 幅 10mm 銅帯 2" 直径 20mm・1ターン

50Ω - 5W-P (金被) → 異常発振すれば焼けてしまう。
for 4CX 1000A, etc

② 球の構造上、リードインダクタンスの大きな球(4-1000A等)
には L は多くし、「寄生回路」全体に占めるパラ止め
コイルの割合を比較的大きくとる。(Qタンクを充電するため)
一方、リードインダクタンスの小さな球(3CX3000A等)には
コイルは、低インダクタンスの銅帯(配線とのもの)のみ
2"も充分なことが多いため。



• L が大きいときは、R のワット-シは
大きいものが必要(HF=HF帯
ハイバンド)に対応(2")。

③ VHF帯の発振対策(Qタンク)

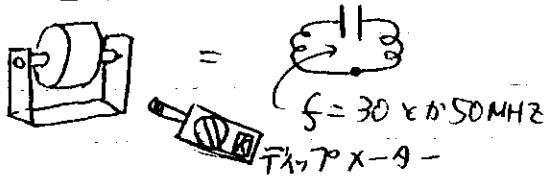
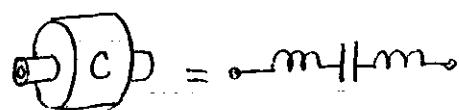
なのであるから、VHF帯2"も

無誘導～ロードインダクタンスの R を

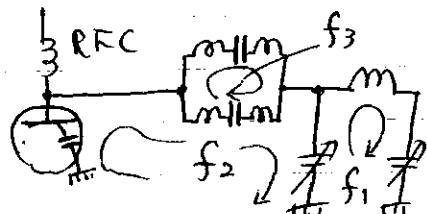
使わないといふ意味もない。

④ コイルの巻き方(間隔、ターン数)を変えたら、発振が止めた、
という話もあるので、研究してみること。(これは重要!)

コンデンサーの並列の問題点



たとえば、 $15KV - 1000pF$ のセラミック C には、自己共振点 $30MHz$ とか $50MHz$ にあるほどいのインダクタンスがある。
(ディップ X-ターンと銅板 2) (測定 12 みるといい)

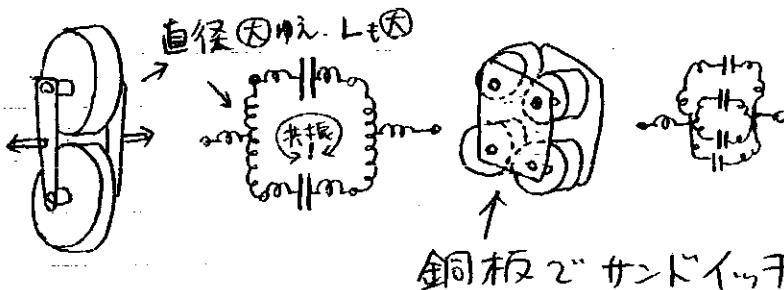


前述の f_1 (基本周波数) と回路上の寄生共振 f_2 のほかに、プローチニアコンデンサーを 2 ヶ (以上) 並列接続した場合には、これ自体で f_3 となる共振回路を形成します。

ここの送信周波数帯域内に f_3 が入る場合、もし f_3 で送信したら、「直列共振回路の共振点でのインピーダンス = 0 」ゆえ、各コンデンサーに高電流が発生し、大きな発熱、破壊を生じることがあります。

* セラミック C の定格は、例えば「 $50^\circ C$ における耐圧」と決めるところ。使用温度がこれを越える場合 (球の近くにある時など)、定格よりも使用電圧、電流は下げるを使わなくてはならない。
(ディレーティング、derating)

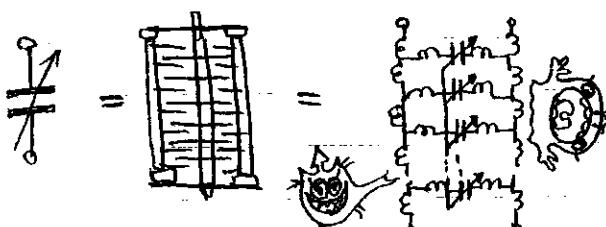
例 $50^\circ C \cdot 10KV$ (定格) $\rightarrow 80^\circ C \cdot 5KV_{-max} = DC E^{\infty}$
 $5KV$ (") $\rightarrow .. 2.5KV_{-max}$ ($EP = 3KV_{-max}$)



例えば「 $22KV \cdot 2000pF$ を作る。
大型 $1000pF \times 2$ もりも。
中型 $500pF \times 4 \rightarrow$
(= テコン、43.5 位、5KW 可)

* f_3 は 使用帯域より充分高い周波数に持ち上げること。

* ハリコン (特に 数 KV - 数百 pF という) は、HF 帯基本波から見れば「ただの C」たゞと云う。高調波～VHF 帯ハリコン共振の見地からは、とても住みごこち良い巣です。



大～小容量まで、小さなサイズで可変できる真空ハリコン (しかも低インダクタンス !!) の魅力はここにもあります。